

СОДЕРЖАНИЕ

Том 47, номер 1, 2018

ТЕХНОЛОГИЯ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Процессы атомно-слоевого осаждения для формирования структуры затворного HkMG-стека с минимальным топологическим размером 32 нм

К. В. Руденко, А. В. Мяконьких, А. Е. Рогожин, О. П. Гуцин, В. А. Гвоздев

3

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Моделирование эффектов воздействия внутренних механических напряжений на кинетику распада пересыщенного раствора кислорода в кремнии

Т. М. Махвиладзе, М. Е. Сарычев

14

TCAD-моделирование эффектов воздействия одиночных ядерных частиц на ячейки памяти STGDICE

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин

23

ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Обнаружение дефектов на поверхности полупроводниковых материалов с использованием диэлектрического барьерного разряда

Д. В. Ситанов, С. А. Пивоваренок

38

Исследование термодинамических характеристик анодного оксида алюминия

А. И. Воробьева, Д. Л. Шиманович, О. А. Сычева

45

ФОТОЛИТОГРАФИЯ

Основные приемы увеличения разрешающей способности фотополимеризующихся композиций

В. М. Треушников, С. П. Молодняков, В. В. Семенов

56

СХЕМОТЕХНИКА

Система логического проектирования функциональных блоков заказных КМОП СБИС с пониженным энергопотреблением

П. Н. Бибило, Н. А. Авдеев, С. Н. Кардаш, Н. А. Кириенко, Ю. Ю. Ланкевич, И. П. Логинова, В. И. Романов, Д. И. Черемисинов, Л. Д. Черемисинова

72

Вниманию авторов

89